

عنوان مقاله:

بررسی اثر میدان مغناطیسی بر نانو سیال رسا

محل انتشار:

اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

سعید رحمانی - دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

میلاد طاهرخانی - دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

خلاصه مقاله:

ویسکوزیته نانوسیال مغناطیسی اتیلن گلیکول- Fe_4O_3 تحت میدان مغناطیسی ثابت، موازی و در جهت جریان نانوسیال به طور آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش شدت میدان مغناطیسی ویسکوزیته نانوسیال کاهش می یابد. همچنین آزمایشات نشان داد افزایش زمان قرارگیری نانوسیال در معرض میدان مغناطیسی تأثیر کاهش ویسکوزیته نانوسیال را بیشتر میکند.

کلمات کلیدی:

ویسکوزیته نانوسیال مغناطیسی، میدان مغناطیسی، ویسکومتر لوله موئین ، فروفلوئید

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/507211>

